

Transistor FQP12N60C MOSFET, Canal-N, 12 A 600 V TO-220



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFQP12N60C
-------	--------------

Illustration non contractuelle

Transistor FQP12N60C MOSFET, Canal-N, 12 A 600 V TO-220

Transistor FQP12N60C MOSFET, Canal-N, 12 A 600 V

Type de canal N
Courant continu de Drain maximum 12 A
Tension Drain Source maximum 600 V
Résistance Drain Source maximum 0,65 Ω
Tension Grille Source maximum ±30 V
Type de boîtier TO-220AB
Catégorie MOSFET de puissance
Dissipation de puissance maximum 225 W
Dimensions 10.1 x 4.7 x 9.4mm
Température d'utilisation maximum +150 °C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles